

おすすめ! 新商品



SiCの高速スイッチング性能をさらに活かす

4端子SiC MOSFET 650V/1,200V耐圧

SCT3xxx xRシリーズ

4端子パッケージ(TO-247-4L)の採用により、スイッチング損失をさらに約35%低減

パワーソース端子とドライバーソース端子を分離できるため、インダクタンス成分の影響を低減でき
SiCの高速スイッチングを実現できます。

実績のあるトレンチ構造のSiC MOSFETで低消費化

プレーナ型SiCと比べ、オン抵抗が小さく高速スイッチングができ、低消費・低損失化ができます。

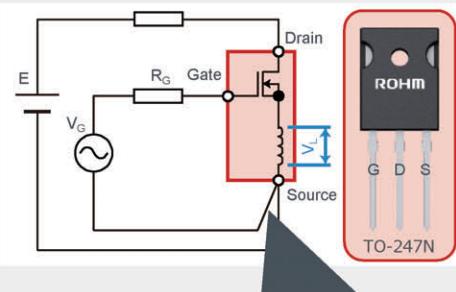


TO-247-4L
4端子 SiC MOSFET

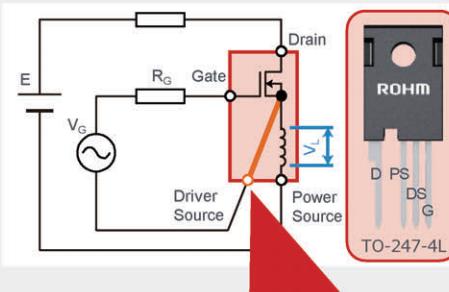
Note: パッケージはJEDEC表記です。

■SiC MOSFET構造比較

SiC MOSFETと4端子SiC MOSFETの構造比較

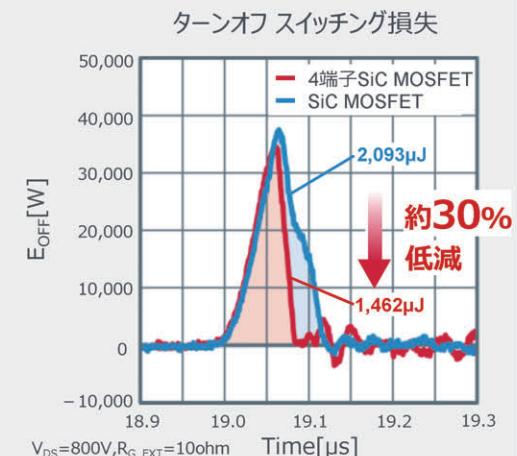
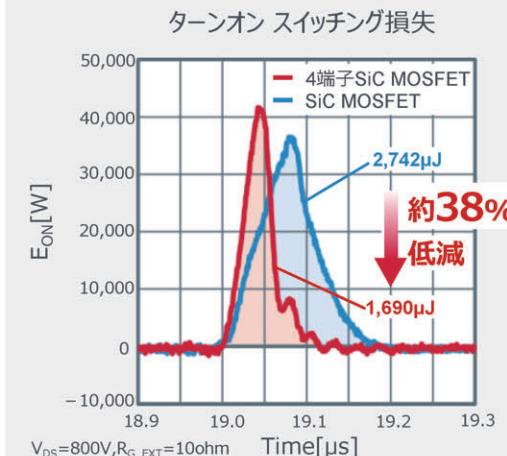


ターンオン・ターンオフ時に発生する
逆起電圧 $V_L(L \cdot dI/dt)$ が
オンオフの妨げとなる



Driver Source端子で V_L の
影響を受けずにスイッチングでき
ロスが削減できる

■高速スイッチングの実現による、損失改善



ターンオン損失とターンオフ損失の合計で
従来品比約35%のスイッチング損失低減

■ 4端子SiC MOSFETシリーズ

品名	極性 (ch)	V_{DSS} (V)	I_D (A)	$P_D(W)$ ($T_C=25^\circ\text{C}$)	$R_{DS(on)}$	Qg		パッケージ
					Typ(mΩ)	Typ(nC)		
New SCT3030AR	N	650	70	262	30	104	18	 TO-247-4L
New SCT3060AR			39	165	60	58	18	
New SCT3080AR			30	134	80	48	18	
New SCT3040KR		1,200	55	262	40	107	18	
New SCT3080KR			31	165	80	60	18	
New SCT3105KR			24	134	105	51	18	

Note: パッケージはJEDEC表記です。

■ SiC MOSFET ハーフブリッジ評価基板



1個から
WEBで購入可能

chip 1stop
An Arrow Company

corestaff
ONLINE



評価ボード品番 : P02SCT3040KR-EVK-001

販売ネット商社 : チップワンストップ、コアスタッフ オンライン、アルエスコンポーネンツ



ローム株式会社

〒615-8585 京都市右京区西院溝町21

www.rohm.co.jp

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも默示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。

本資料の記載内容は 2019 年 11 月 1 日現在のものです。

ローム商品のご用命は